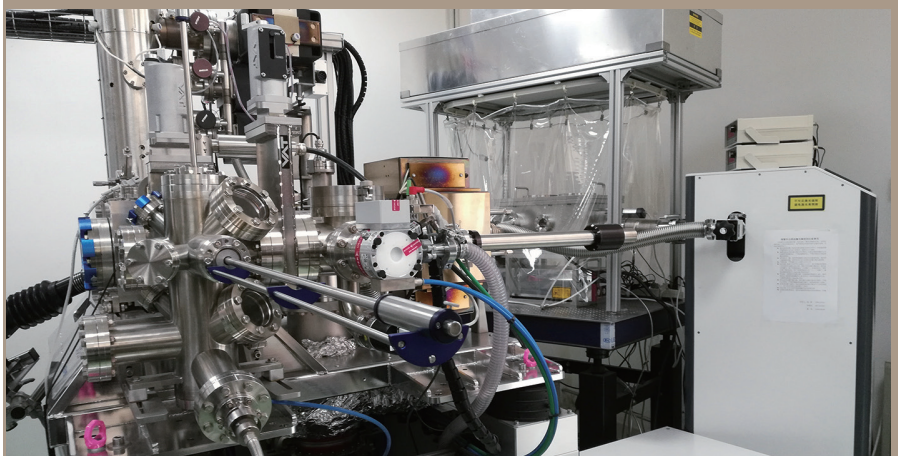
深紫外激光光发射电子显微镜

Deep Ultraviolet Diode-pumped Solid State Laser Photoemission Electron Microscope

DUV-DPL PEEM



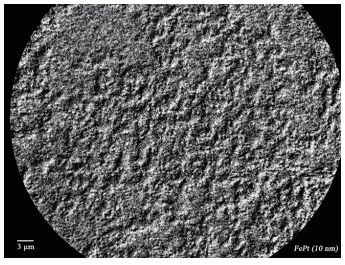
主要技术与性能指标

- PEEM 分辨率：≤ 10 nm
- LEEM 分辨率：≤ 5 nm
- 能量分辨率：≤ 0.2 eV

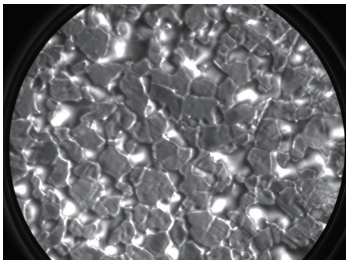
主要应用

表面分析科学中的表面磁学、表面催化、薄膜生长等

代表性应用成果



用于 MgO/Pt/FePt 磁性薄膜成像



用于钡钨阴极材料成像

主要用户单位	中国科学院大连化学物理研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院电子学研究所、中国科学院物理研究所、中国科学技术大学
研制单位	中国科学院理化技术研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院大连化学物理研究所
联系方式	张申金　010-82543470，13488671978　zhangshenjin@163.com 孙占峰　010-82548109，13520785335　zhfsun@kyky.com.cn